

加工

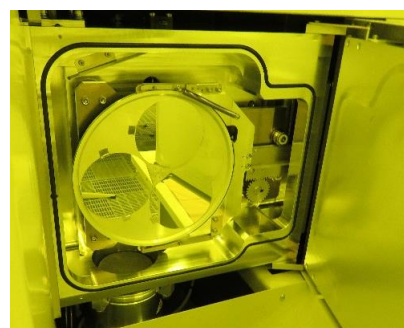
(成膜装置群)

マグネトロンスパッタリング装置

芝浦メカトロニクス社製 CFS-4EP-LL

仕様

- 到達真空度 8×10^{-5} Pa
- 高周波電源 出力500WのRFまたはDC電源
- カソード $\phi 75\text{mm}$ 4基(1基は強磁性体用)
- 基板ホルダ $\phi 220\text{mm}$ (回転機能付)
基板～電極間距離:95～130mm
- 成膜ソース Al, Al-Si, Cr, SiO₂
- 成膜レート Cr 17nm/1min (基板回転時)
SiO₂ 10.5nm/1min (基板回転時)



薄膜形成

本装置はロードロックチャンバー付きのスパッタリング装置です。電源はDCとRFのいずれかを切り替えて処理可能。レシピを組むことで最大10層までを全自動で連続成膜が可能(逆スパッタも含む)。

マニュアルモードでの操作も可能ですので、条件の微調整などにも対応可能です。

- ・逆スパッタ(基板クリーニング)可能
- ・基板加熱性能 300℃まで
- ・サイドスパッタ方式の為、ダストが付着しにくい

「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX:087-887-1873

E-mail: nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp